

IGBT 430V/200A

Número de parte: RJP56F4



Descripción:

Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT), es un dispositivo semiconductor que generalmente se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia.

El transistor IGBT es adecuado para velocidades de conmutación de hasta 100 KHz (en algunos casos menores de 100KHz). Su conmutación es de alta velocidad.

Encapsulado: TO 220FN.

Energía de disipación: De 3W y máxima disipación de 30W.

Voltaje de la fuente: 4.75V a 5.25V.

Voltaje de colector-emisor: 430V.

Corriente de colector: 200A.

Voltaje de compuerta- emisor: $\pm 33V$.

Temperatura de funcionamiento: $-50^{\circ}C$ a $150^{\circ}C$.